

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
G02F 1/136

(11)
(43)

2002 - 0057242
2002 07 11

(21) 10 - 2000 - 0087533

(22) 2000 12 30

(71) 136 - 1

(72)

2	338 - 12	
187		723 406

(74)

(54)

2a

1a 1d

2a 2c .

3 .

* *

10: 11:

15: 17:

19: 19a:

20: 21:

23: 50:

100: (laser)

, , .

, / 가 , / 가 .
 , 가 ,
 , .

(Ion Shower) (Ion Implanter)

가 가

가

, 가 가 10 ~100Kev 가 .

, 가 ,
 , 가 가 .
 가 , 가 가가 .

, , .

가

(furnace)

N⁺ P⁺

100 ~500
250 ~400

1a 1d (50) SiO₂ (20) A - Si (10) 1a (10)
(11) 1b (12) SiN_x
(15) (50) POCl₃ N⁺, P⁺ 가

1c (17) (furnace)
(17) (12) (19)

1d / (21, 23)
(21, 23) (15)

2a 2c (10) (12) 2a (19)
2b (10) / (21,23)

3 2a 2c
(17) (10) (17)

(57)

1.

;

;

;

;

;

/

2.

1

N^+

P^+

가

3.

1

4.

3

100 ~500

5.

1

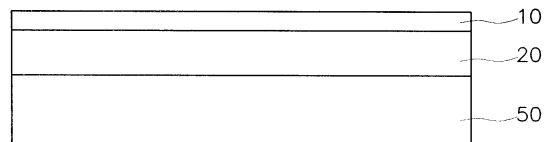
(furnace)

6.

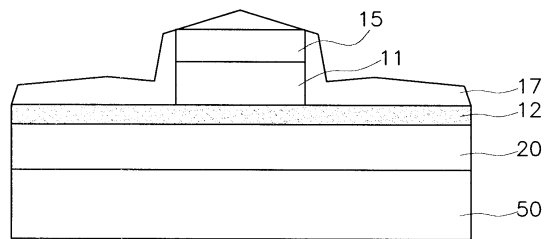
1 5 ,

250 ~400

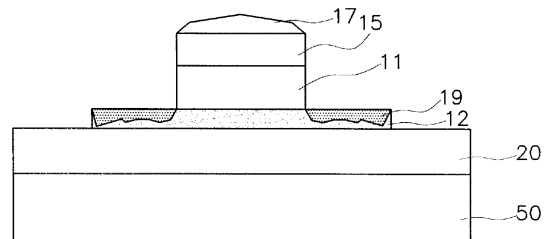
1a



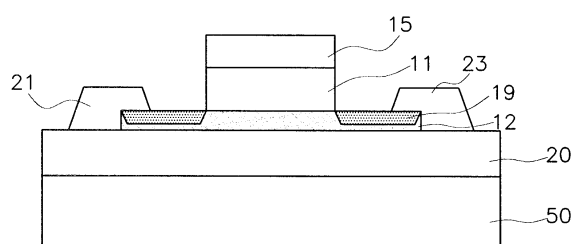
1b



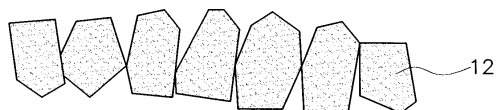
1c



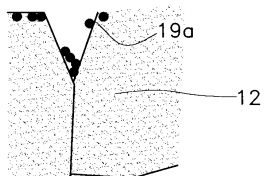
1d



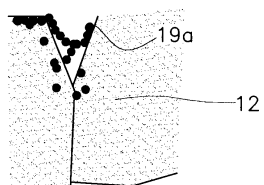
2a

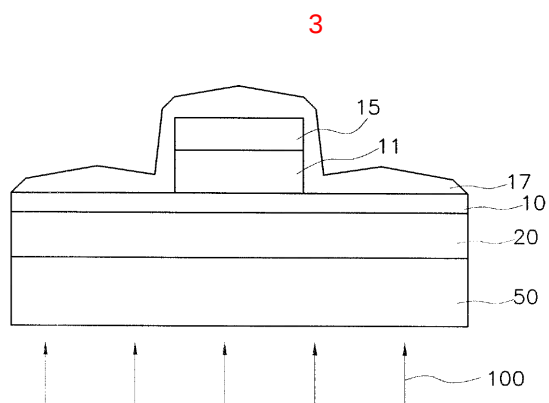


2b



2c





专利名称(译)	薄膜晶体管液晶显示装置的制造方法		
公开(公告)号	KR1020020057242A	公开(公告)日	2002-07-11
申请号	KR1020000087533	申请日	2000-12-30
[标]申请(专利权)人(译)	HYDIS TECH HYDIS技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
当前申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
[标]发明人	JEONG CHANGYONG 정창용 KIM INKYO 김인교		
发明人	정창용 김인교		
IPC分类号	G02F1/136		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明公开了一种薄膜晶体管液晶显示器的制造方法。所公开的发明包括在玻璃基板上沉积绝缘层的步骤：在绝缘层上沉积多晶硅层的步骤：形成欧姆接触的步骤和在基板上接触的源/漏电极。涂覆掺杂层的步骤：在栅电极两侧的多晶硅层部分的表面上形成欧姆接触的步骤，对结果进行热处理：形成欧姆接触。

